

国产MOS场效应晶体管阈值电压不稳定性的初步探讨

孙涛, 陈心和

()

中图分类号:

摘要: 阐述了引起MOS场效应晶体管阈值电压不稳定性的几种主要因素, 介绍国外对p沟MOS晶体管所做的加速试验的结果。对国产MOS晶体管的阈值电压进行了BT试验。同一类型的管子在不同应力下观察到类似的现象。作图表示阈值电压漂移的平均值随应力时间的变化, 从而确定漂移机构。

关键词: 无

 [阅读文章\(pdf\)](#)

关闭本页